

製品仕様書

部長	総括	検印	担当
(国田)	(近藤)		(西尾)

名称	200W樹脂封止型シリコンパワートランジスタ	日付	1994 - 11 - 14
	2SB1621	担当	半導体本部技術統括部 応用技術二部TR技術グループ

1. 適用範囲

この規格は、樹脂封止型シリコンパワートランジスタ2SB1621について適用する。

2. 外観・構造

2-1 外観

本体は、汚れ、サビ、キズ等なく美観であること。

2-2 外形と寸法

図1のとおりとする。

2-3 標示

本体に明瞭に品名、ロット番号を容易に消えぬよう白色で捺印すること。

SSE-19841

1/3

サンケン電気株式会社

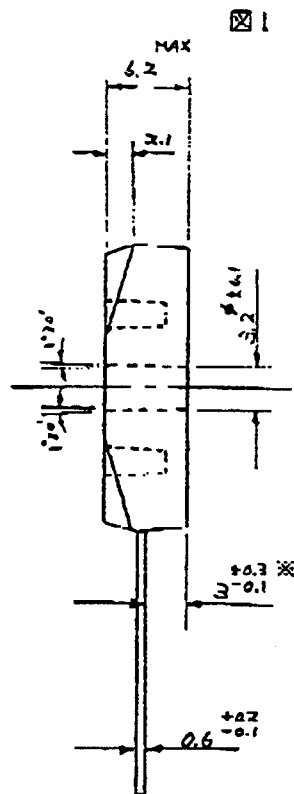
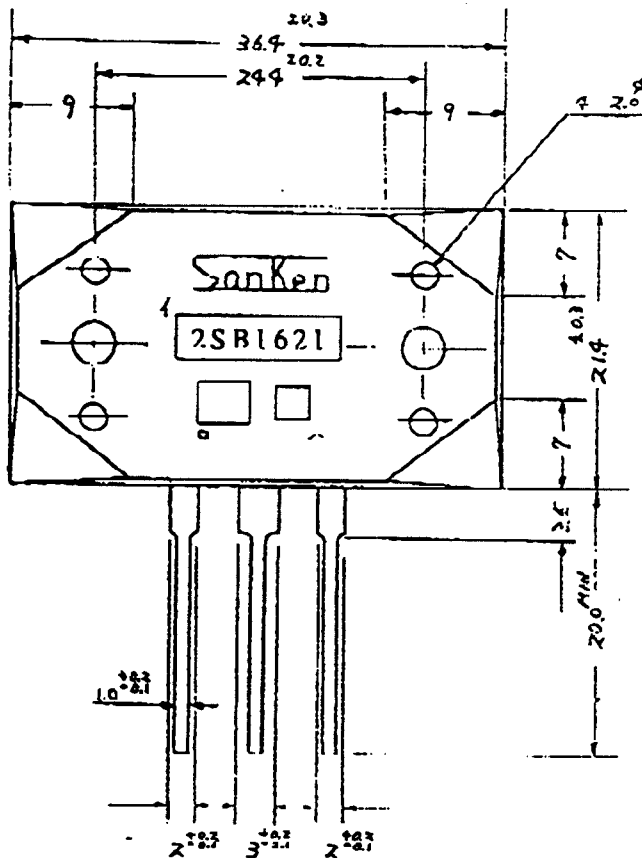
## 3. 定 格

## 3-1 絶対最大定格(周囲温度 25℃)

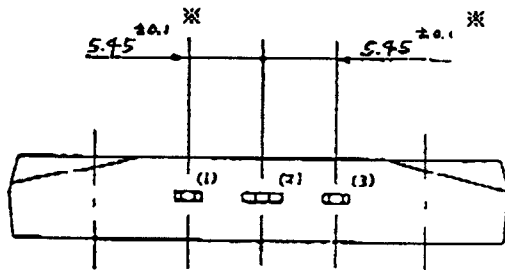
項 目	記号	2SB1621
コレクタ・ベース電圧	$V_{CBO}$	200V
コレクタ・エミッタ電圧	$V_{CEO}$	-200V
エミッタ・ベース電圧	$V_{EBO}$	-5V
コレクタ電流	$I_C$	17A
ベース電流	$I_B$	-1A
許容損失	$P_C$	200W(フランジ温度25℃)
接合部温度	$T_j$	150℃
保存温度	$T_{stg}$	-55~+150℃

## 3-2 電気的特性(周囲温度 25℃)

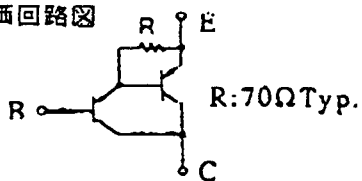
項 目	記号	2SB1621
最大コレクタ遮断電流 ( $V_{CB} = -200V, I_E = 0A$ )	$I_{CBO}$	-100 $\mu$ A Max
最大エミッタ遮断電流 ( $V_{EB} = -5V, I_C = 0A$ )	$I_{EBO}$	-100 $\mu$ A Max
コレクタ・エミッタ電圧 ( $I_C = -30mA$ )	$V_{CEO}$	-200V Min
直流電流増幅率 ( $V_{CE} = -4V, I_C = -10A$ )	$h_{FE}$	5000-12000 (O) 6500-20000 (P) 15000-30000 (Y)
コレクタ飽和電圧 ( $I_C = -10A, I_B = 10mA$ )	$V_{CE(sat)}$	-2.5V Max
ベース・エミッタ飽和電圧 ( $I_C = -10A, I_B = -10mA$ )	$V_{BE(sat)}$	-3.0V Max
遮断周波数 ( $V_{CE} = -12V, I_E = 2A$ )	$f_T$	60MHz Typ
コレクタ接合容量 ( $V_{CB} = -10V, I_E = 0A, f = 1MHz$ )	$C_{ob}$	270pF Typ



- (1) ベース
- (2) コレクタ
- (3) エミッタ



等価回路図



- イ. 品名標示
- ロ. ロット標示 二桁
  - 第1文字 製造年
    - 0-9 西暦年号下一桁
  - 第2文字 製造月
    - 1-9月 アラビア数字
    - 10月 O
    - 11月 N
    - 12月 D
- ハ. hFE標示

リード端子	Cu	Niメッキ
外部ヒートシンク	Cu	Niメッキ
内部ヒートシンク	Cu	Niメッキ
名称	材質	仕 様

リード端子は半田ディップ処理

〈注〉※印寸法は、リード根元部の寸法を示す。

単位: mm

△	4版 . . .	照 査 承 認	名 称	MT200	
△	3版 . . .	製 図			外形寸法図
△	2版 . . .				
△	1版 . . .	図 番			4B-E01143 3/3
関連 図番	サンケン電気株式会社	登録 53・12・21 尺 度 2/1	分 類 名	SSE-19841	